

1НТ251А, Транзисторная матрица

для приобретения (купить, заказать) данного товара напишите нам на sales@iElekt.ru или перейдите по ссылке на страницу покупки заинтересовавшего Вас товара: [ЗАКАЗАТЬ](#).

Вернуться на "главную" страницу сайта [ГЛАВНАЯ](#).

Согласовать цену, уточнить наличие и условия поставки компонентов или связаться с менеджером. Перейдите в раздел [КОНТАКТЫ](#).

1НТ251А матрицы полупроводниковой:

1НТ251А — транзисторная матрица (артикулярное наименование по ГОСТ) полупроводниковые транзисторные матрицы кремний эпитаксиальнопланарные системы NPN назначение для использования в быстродействующих импульсных и переключающих устройствах. Сборки биполярные полупроводниковые состоят из четырех электрически изолированных переключающих СВЧ транзисторов и используются в РЭА в широком спектре использования. Матрицы выполнены в стеклометаллическом корпусе. Модель прибора, знак завода и дата выпуска наносится на верхней металлической части корпуса. Климатическое исполнение УХЛ и соответствует техническим условиям 2) 3.456.000 ТУ.

Ссылки на технические материалы

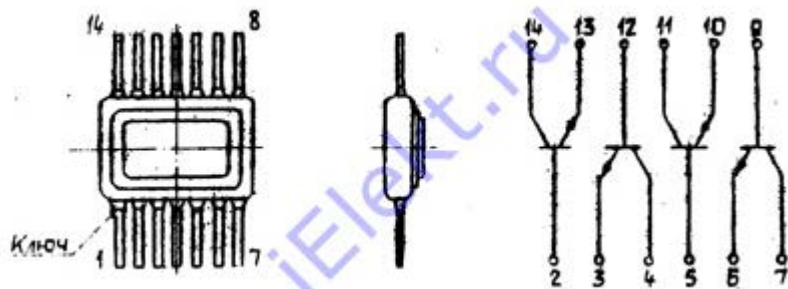
ссылки на дополнительный материал:

карта	фото	схема выводов
значение выводов	габариты	параметры
эксплуатация	PDF	

Знак завода изготовителя



Расположения выводов схематическое, назначение выводов, габаритные размеры, маркировка



Вес не превышает 0,4г.

Основные электро параметры при $t=25\pm 10$ градусов Цельсия

основные электро параметры:

Наименование параметра (режим замера), единица замера	Обозначение буквой	Допуск			
		1НТ251		1НТ251А	
		больше	меньше	больше	меньше
Статический КП тока в схеме с общим эмиттером ($U_{кб}=5V$, $I_{э}=200mA$, $f=50Hz$)	$h_{21э}$	30	150	30	150
Инверсный ток коллектор, μA ($U_{кб}=45V$)	$I_{кбо}$	-	6	-	6
Инверсный ток эмиттера, μA ($U_{эб}=4V$)	$I_{эбо}$	-	10	-	10
Время рассасывания, ns ($I_{к}=150mA$, $I_{б1}=I_{б2}=15mA$)	$t_{рас}$	-	100	-	200
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер, V ($I_{б}=80mA$, $I_{к}=400mA$)	$U_{кэнас}$	-	1,0	-	1,0
Напряжение насыщения база-эмиттер, V ($I_{б}=80mA$, $I_{к}=400mA$)	$U_{бэнас}$	-	1,5	-	1,5
Модуль КП тока на высших частотах ($U_{кэ}=10V$, $I_{к}=30mA$, $f=10^8Hz$)	$ h_{21э} $	2	-	2	-
Емкость коллекторного перехода, pF ($U_{кб}=10V$, $f=5\cdot 10^6Hz$)	C_k	-	15	-	15
Емкость 1НТ251А эмиттерного перехода, pF ($U_{эб}=0V$, $f=5\cdot 10^6Hz$)	$C_э$	-	50	-	50

© ЭЛЕКТ (iElekt.ru) - радиодетали и электронные компоненты оптом со склада в Санкт-Петербурге и на заказ, отечественных и зарубежных производителей почтой во все регионы России

Доставка в города: Нальчик, Нарьян-Мар, Вологда, Курск, Краснодар, Липецк, Сыктывкар, Омск, Симферополь, Санкт-Петербург, Петропавловск-Камчатский, Воронеж, Киров, Пермь, Горно-Алтайск, Псков, Салехард, Волгоград, Владимир, Нижний Новгород, Ульяновск, Пенза, Калуга, Саранск, Челябинск, Грозный, Московская область, Уфа, Владивосток, Кызыл, Томск, Чита, Казань, Смоленск, Элиста, Тула, Астрахань, Екатеринбург, Дудинка, Курган, Якутск, Иркутск, Новосибирск, Калининград, Барнаул, Кемерово, Ростов-на-Дону, Хабаровск, Ставрополь, Ханты-Мансийск, Абакан, Владикавказ, Магадан, Рязань, Красноярск, Оренбург, Биробиджан, Благовещенск, Магас, Великий Новгород, Белгород, Южно-Сахалинск, Тюмень, Петрозаводск, Чебоксары, Кострома, Ярославль, Орел, Анадьрь, Махачкала, Майкоп, Самара, Черкесск, Мурманск, Йошкар-Ола, Ижевск, Москва, Тамбов, Улан-Удэ, Иваново, Архангельск, Тверь, Брянск, Саратов.